

**High Electron Mobility Transistor, HEMT, 1979**

The HEMT, invented in 1979, was the first transistor to incorporate an interface between two semiconductor materials with different energy gaps. HEMT proved superior to previous transistor technologies due to high mobility of channel carriers, resulting in high speed and high frequency performance. HEMTs have been widely used in radio telescopes, satellite broadcasting receivers and cellular base stations, giving rise to a fundamental technology supporting the information and communication society.

Dec 2019

**高電子移動度トランジスタ HEMT、1979年**

1979年に発明された HEMT はエネルギーギャップの異なる 2 つの半導体の界面をデバイス構造に組み込んだ最初のトランジスタである。HEMT はチャネルキャリアの移動度が高いため、従来のトランジスタよりも高速動作が可能である。HEMT は電波望遠鏡や衛星放送受信機、モバイル通信の基地局などで広く利用されており、情報通信社会を支える基盤技術の発展に貢献した。

2019年12月

2019年12月18日、「高電子移動度トランジスタ HEMT」の IEEE マイルストーン記念式典が、帝国ホテル 東京にて開催され、福田 敏男 IEEE 次期会長より、株式会社富士通研究所 原 裕貴 代表取締役社長に、業績を記した銘板が贈呈されました。銘板は、富士通研究所 厚木(神奈川県厚木市森の里若宮 10-1)に展示されています。

**IEEE Milestone 銘板****銘板と記念撮影**

(左から) 徳田 英幸 IEEE 東京支部 Chair、福田 敏男 IEEE 次期会長、富士通研究所 原 裕貴 社長、富士通研究所 三村 高志 名誉フェロー

**HEMT の実物展示****IEEE Milestone 認定の経過:**

- 2017年11月21日 Proposal Form 提出
- 2019年5月22日 Board of Directors 承認
- 2019年12月18日 記念式典開催 (場所) 帝国ホテル 東京

**銘板設置場所:** 富士通研究所 厚木(神奈川県厚木市森の里若宮 10-1)